

Title (en)
SEMICONDUCTOR DEVICE.

Title (de)
HALBLEITERANORDNUNG.

Title (fr)
DISPOSITIF SEMI-CONDUCTEUR.

Publication
EP 0316397 A1 19890524 (EN)

Application
EP 88904600 A 19880606

Priority
GB 8713403 A 19870609

Abstract (en)
[origin: GB2206235A] A semiconductor switching element including a FET and transmission line (11, 13) whereby the transmission line is mounted around the active channel (15) of the FET with a gate electrode stripe (17) therebetween. The transmission line (11, 13) is thus capable of being short-circuited to earth by application of a suitable electrical potential to the gate electrode. This allows construction of a microwave phase shift circuit which makes maximum use of the available area of semiconductor material.

Abstract (fr)
Un élément commutateur semi-conducteur comprend une ligne de transmission et de transistor à effet de champ (11, 13), la ligne de transmission étant montée autour du canal actif (15) du transistor à effet de champ, séparé de celui-ci par une grille allongée (17). La ligne de transmission (11, 13) peut ainsi être court-circuitée par mise à la terre lorsque l'on applique un potentiel électrique approprié à la grille, ce qui permet de construire un circuit de déphasage de micro-ondes qui utilise au maximum la zone disponible en matériau semi-conducteur.

IPC 1-7
H01P 1/185

IPC 8 full level
H01P 1/185 (2006.01)

CPC (source: EP)
H01P 1/185 (2013.01)

Citation (search report)
See references of WO 8810012A1

Designated contracting state (EPC)
DE FR NL

DOCDB simple family (publication)
GB 2206235 A 19881229; GB 2206235 B 19901219; GB 8813305 D0 19880713; EP 0316397 A1 19890524; GB 8713403 D0 19870715; JP H02500236 A 19900125; WO 8810012 A1 19881215

DOCDB simple family (application)
GB 8813305 A 19880606; EP 88904600 A 19880606; GB 8713403 A 19870609; GB 8800442 W 19880606; JP 50450388 A 19880606